

## ПК «ЯДРО»

### КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ ПАРА КРЕМНИЕВЫХ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ со СВЕРХМАЛЫМ ПРЯМЫМ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

Транзисторы предназначены для применения в переключательных, импульсных схемах с низким напряжением насыщения и другой аппаратуре.

Транзисторы соответствуют АДБК 432140.943 ТУ

#### Основные параметры

Параметр	Обозн.	КТ529А КТ530А	Единицы измерения
Обратный ток коллектора ( $U_{cb}=80$ В)	$I_c$	1	МкА
Обратный ток эмиттера ( $U_{eb}=4$ В)	$I_e$	1	МкА
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ( $I_c/I_b=(300/10)$ мА)	$U_{ce}$	0.2	В
Статический коэффициент передачи тока ( $U_{ce}=5$ В, $I_c=300$ мА)	$h_{21e}$	180	
Граничное напряжение ( $I_e=10$ мА)		40	В
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ( $U_{ce}=5$ В, $I_e=300$ мА, $f=100$ МГц)		1.5	

#### Предельно-допустимые параметры

Параметр	Обозн.	КТ529А КТ530А	Единицы измерения
Максимальное постоянное напряжение коллектор- эмиттер	$U_{ce\ max}$	60	В
Максимальное постоянное напряжение эмиттер-база	$U_{eb\ max}$	4	В
Максимально допустимый постоянный ток коллектора	$I_c\ max$	1	А
Рассеиваемая мощность	$P\ max$	0.5	Вт
Рабочая температура окружающей среды	$T_{amb}$	-60...+85	°С

Розничная цена транзисторов – 3 руб. Цена в партии 100 шт. – 1,98 руб.

pnp  
КТ529А  
npr  
КТ530А

$I_c\ max\ 1\ A$   
 $U_c\ max\ 60\ V$   
 $P\ max\ 0,5\ W$



1.база  
2.коллектор  
3.эмиттер

условная маркировка

КТ529 - ГП  
КТ530 - ГН

∇ - товарный знак  
изготовителя